

第15回表面科学講演大会

真下正夫

東芝研究開発センター
 ☎210 川崎市幸区小向東芝町1
 (1996年4月30日受理)

The 15th Annual Meeting of the Surface
Science Society of Japan

Masao MASHITA

Toshiba Research and Development Center
 1, Komukai Toshiba-cho, Saiwai-ku, Kawasaki 210

(Received April 30, 1996)

定例の本学会主催第15回表面科学講演大会が平成7年11月28日から30日まで早稲田大学総合学術情報センターで開催された。今回は平成6年に発足した講演大会委員会の実質的な効果が期待された最初の講演大会といえることができる。当委員会により講演大会の企画運営に関する議論を重ねた結果、いくつか新しい試みを行うことができた。その1つは講演大会の講演募集と当日参加をそれぞれ呼びかけるためのポスターを2度にわたって作成し、講演大会を会員外にも広くアピールすることに努めた。その他、これまでのシンポジウム形式に代わって各セッションごとに1~3件、その分野を代表する先生方に招待講演をお願いして講演会場を大いに盛り上げるよう配慮した。これらのことが功を奏してか今回は発表件数も参加者数もこれまでに比べて飛躍的に増加した。

一般講演は152件(前回116件,以降括弧内は前回数)あり,その内訳は表面分析・評価38件(23件),表面物理34件(22件),表面化学・触媒26件(24件),STM・AFM 21件(22件),半導体13件(9件),薄膜11件(6件),表面処理6件(5件),超伝導3件(5件)であった。セッション間の区分けは厳密ではないが,表面分析・評価と表面物理の件数の伸びが目立つ。一方,半導

体や薄膜などはそれらの研究人口に比べて非常に少ないと思われる。表面科学は半導体や薄膜分野の基礎を形成する重要な学問の1つであり,当分野の技術革新のためには不可欠と考えられる。今後の企画に当たってはこの観点からの配慮も必要である。参加者数は325名(271名)で,その内訳は会員220名(195名),学生93名(68名),一般12名(9名)であった。

受賞講演は論文賞: γ -ピスマスモリブデート表面の Ar^+ スパッタリングによる還元挙動と加熱および O_2 -Jet による再酸化挙動(室蘭工大)内田浄孝, 苜蒲明己, 奨励賞: 斜入射・斜出射-蛍光X線分析法による表面・薄膜分析(東北大金研)辻 幸一, および技術賞: 磁石内蔵型マイクロ・スパッタリング装置(2)一試作とその応用例一(東理大工)渡部一史, 杉田利男, 西川英一であった。技術賞は今回から新設された賞である。特別講演は3件あり, STMの現状と将来-トンネル接合としてのSTM(京大工)酒井 明, レーザーを用いるアトムカウンティング-単原子検出はどこまで可能か(電総研)一村信吾, および液滴エピタキシ法によるGaAs量子ドットの作製(金材技研)小口信行であった。招待講演は13件あり, 紙面の関係上, 講演者名のみ紹介すると, 表面物理: 相沢 俊(無機材研), 長谷川修司(東大理), 表面化学: 岩澤康裕(東大院理), 田中虔一(東大物性研), 宮崎栄三(東工大), 表面分析: 田沼繁夫(ジャパンエナジー), 吉武道子(金材技研), 松本 潔(旭ガラス中研), STM, AFM: 長谷川哲也(東大工), 河津璋(東大工), 薄膜: 犬塚直夫(青学大理工), 吉田政次(NEC基礎研), 半導体: 越田信義(農工大工)であった。以上敬称は省略させていただきました。

講演大会は学会最大のイベントであると同時に会員から学会の存在意義が厳しく評価される重要な機会でもあり, 講演大会を支える大会委員会はまた機能し始めたばかりであり, さらに充実させていく必要がある。

最後にご講演をいただいた諸先生方および運営にご協力いただいた早稲田大学関係の方々には御礼申し上げます。残念にも招待講演者の犬塚直夫先生は平成8年2月29日に急逝されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。